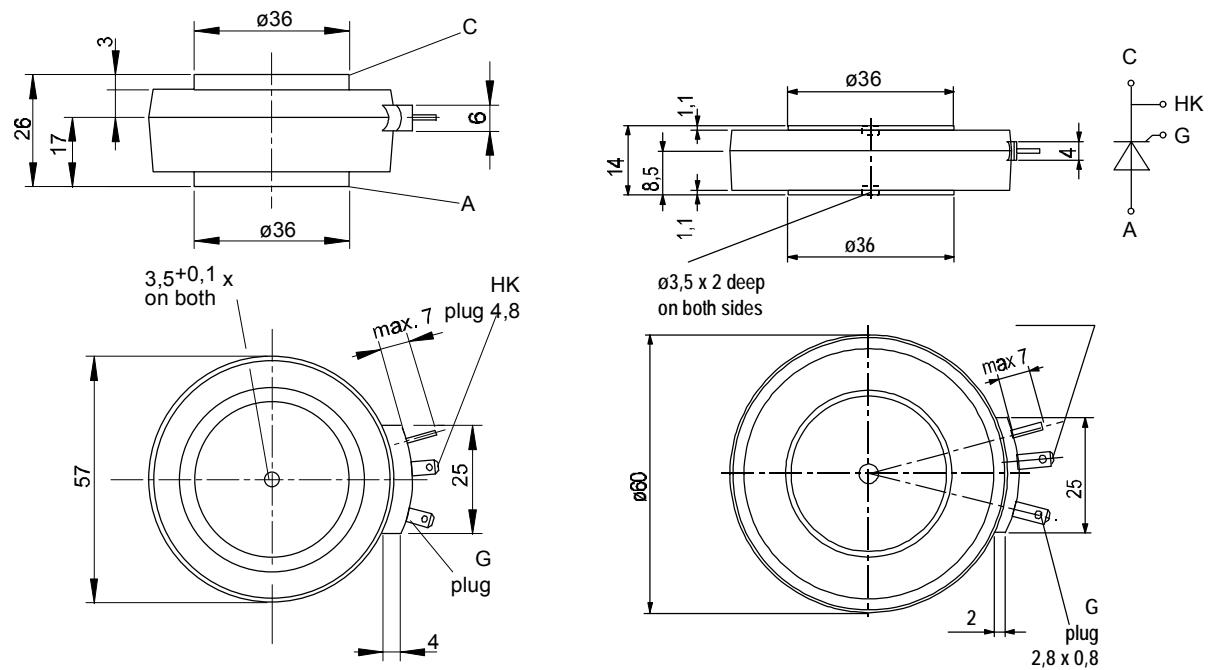




European Power-
Semiconductor and
Electronics Company

Marketing Information T 699 N / T 708 N



T 699 N

Elektrische Eigenschaften

Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung

Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung

Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromteilheit

Kritische Spannungsteilheit

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

$I^2 t$ -value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$

$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$

$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$

V_{DRM}, V_{RRM}

1800 2000 2200

V

$V_{DSM} = V_{DRM}$

1800 2000 2200

V

$V_{RSM} = V_{RRM}$

1900 2100 2300

V

I_{TRMSM}

1500

A

I_{TAVM}

699

A

I_{TSM}

950

A

I_{GM}

13500

A

$I^2 t$

12200

A

$i_{GM} = 1 \text{ A}$, $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$

744000

A^2s

$(di_T/dt)_{cr}$

200

$\text{A}/\mu\text{s}$

$(dv_D/dt)_{cr}$

1000

$\text{V}/\mu\text{s}$

5.Kennbuchstabe/5th letter F

Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzug

Freiwerdezeit

Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

$t_{vj} = t_{vj\ max}$, $i_T = 2850 \text{ A}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$, $V_D = 6 \text{ V}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$, $V_D = 0,5 \text{ V}_{DRM}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$, $V_D = 0,5 \text{ V}_{DRM}$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 6 \text{ V}$, $R_A = 5 \Omega$

$t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 6 \text{ V}$, $R_{GK} > 10 \Omega$

$i_{GM} = 1 \text{ A}$, $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$, $t_g = 20 \mu\text{s}$

$t_{vj} = t_{vj\ max}$, $V_D = V_{DRM}$, $V_R = V_{RRM}$

DIN IEC 747-6 $t_{vj}=25^\circ\text{C}$, $i_{GM} = 1 \text{ A}$, $di_G/dt = t_{gd}$

$= 1 \text{ A}/\mu\text{s}$

$t_{vj}=t_{vj\ max}$, $i_{TM}=i_{TAVM}$, $V_{RM}=100\text{V}$, $V_{DM}=0,67$

V_{DRM} , $dv_D/dt=20\text{V}/\mu\text{s}$,

$di_r/dt=1\text{A}/\mu\text{s}$

4.Kennbuchstabe/4th letter O

V_T

max. 2,32

V

$V_{T(TO)}$

0,95

V

r_T

0,45

$\text{m}\Omega$

I_{GT}

max. 250

mA

V_{GT}

max. 2,2

V

I_{GD}

max. 10

mA

V_{GD}

max. 0,25

V

I_H

max. 300

mA

I_L

max. 1500

mA

i_D, i_R

max. 100

mA

t_g

max. 4,0

μs

t_q

typ. 300

μs

Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand, beidseitig

Thermal properties

thermal resistance, junction to case for two-sided cooling

$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$

R_{thJC}

max. 0,0320

$^\circ\text{C/W}$

DC

$R_{thJC(A)}$

max. 0,0300

$^\circ\text{C/W}$

for anode-sided cooling

$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$

$R_{thJC(K)}$

max. 0,0537

$^\circ\text{C/W}$

DC

R_{thCK}

max. 0,0511

$^\circ\text{C/W}$

for cathode-sided cooling

$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$

R_{thCK}

max. 0,0816

$^\circ\text{C/W}$

DC

R_{thCK}

max. 0,0732

$^\circ\text{C/W}$

Übergangs-Wärmewiderstand

thermal resistance, case to heatsink

beidseitig/two-sided

R_{thCK}

max. 0,005

$^\circ\text{C/W}$

einseitig/one-sided

$t_{vj\ max}$

125

$^\circ\text{C}$

Höchstzul. Sperrsichttemperatur

max. junction temperature

$t_{c\ op}$

-40...+125

$^\circ\text{C}$

Betriebstemperatur

operating temperature

t_{stg}

-40...+140

$^\circ\text{C}$

Lagertemperatur

storage temperature

Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Si-Elemente mit Druckkontakt, Amplifying- Si-pellet with pressure contact,amplifying

Gate

gate

F

10,5...21

kN

Anpreßkraft

clamping force

G

typ. 280

g

Gewicht

weight

25

mm

Kriechstrecke

creepage distance

C

Feuchteklasse

humidity classification

DIN 40040

50

m/s²

Schwingfestigkeit

vibration resistance

f = 50 Hz

Maßbild, anliegend

outline, attached

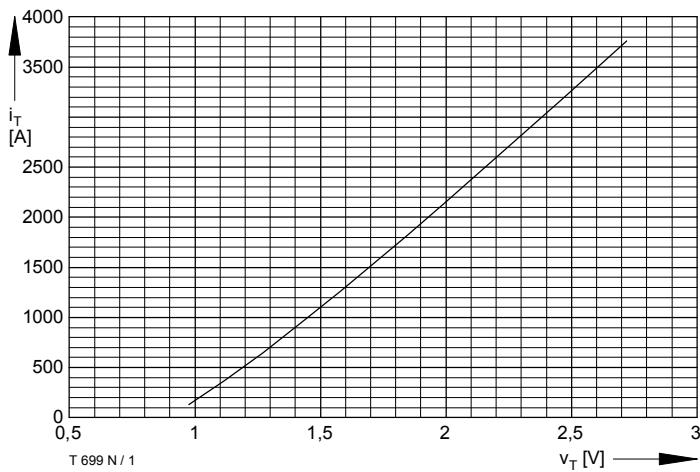


Bild / Fig. 1
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic
 $i_T = f(v_T)$, $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{\text{thn}} [\text{°C/W}]$	0,000134	0,001636	0,00195	0,00968	0,01680
$\tau_n [\text{s}]$	0,000183	0,00166	0,00937	0,119	0,939

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{\text{thn}} [\text{°C/W}]$	0,000455	0,003885	0,00331	0,0138	0,02965
$\tau_n [\text{s}]$	0,000251	0,00243	0,0544	0,183	1,14

Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{\text{thn}} [\text{°C/W}]$	0,000708	0,007242	0,0137	0,02665	0,0249
$\tau_n [\text{s}]$	0,00032	0,00387	0,0232	0,138	0,9

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{\text{thJC}} = \sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} R_{\text{thn}} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$